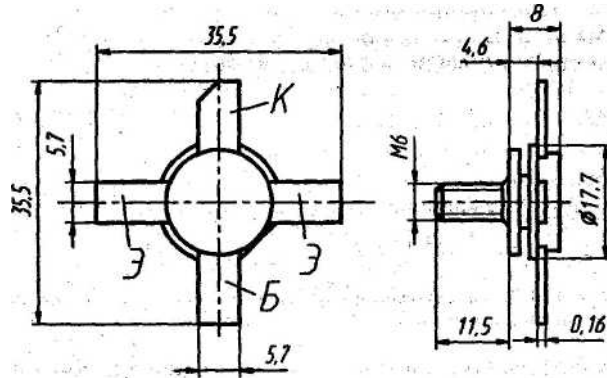


А639А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* усилительный линейный. Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 30...80 МГц при напряжении питания 40 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 11 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Коэффициент усиления по мощности на частоте $f = 80$ МГц при $U_n = 40$ В, $P_{\text{вых}} = 150$ Вт, не менее	5
Коэффициент полезного действия коллектора на частоте $f = 80$ МГц при $U_n = 40$ В, $P_{\text{вых}} = 150$ Вт, не менее	40%
Коэффициент комбинационных составляющих 3-го и 3-го порядков на частоте $f = 80$ МГц при $U_n = 40$ В, $P_{\text{вых}} = 150$ Вт, не более	-27 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_k = 5$ А, не менее	10
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 20$ В, $I_k = 2$ А, не менее	150 МГц
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 80$ В, не более	100 мА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = 80$ В, $R_{бэ} = 10$ Ом, не более	100 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	500 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания	40 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	80 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
$T_k = -60...+50$ °С	200 Вт
$T_k = +125$ °С	100 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме:	
$T_k = -60...+50$ °С	200 Вт
$T_k = +125$ °С	100 Вт
Входная высокочастотная мощность, падающая на вход транзистора	40 Вт
КСВН коллекторной цепи при $P_{\text{вых}} = 100$ Вт, любой фазе рассогласования в течение 1 с	30
Температура <i>p-n</i> перехода	+200 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	0,75 °С/Вт
Температура окружающей среды	— 60... $T_k = +125$ °С

Допускается работа транзистора в диапазоне частот 1... 30 МГц и свыше 80 МГц, при этом параметры не регламентируются.

Пайка, выводов допускается не ближе 2 мм от корпуса при температуре не выше +260 °С в течение не более 8 с и ближе 2 мм при температуре не выше +150 °С.